

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-252421

(43)Date of publication of application : 06.09.2002

(51)Int.Cl.

H01S 5/323
H01L 21/205

(21)Application number : 2001-051348

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 27.02.2001

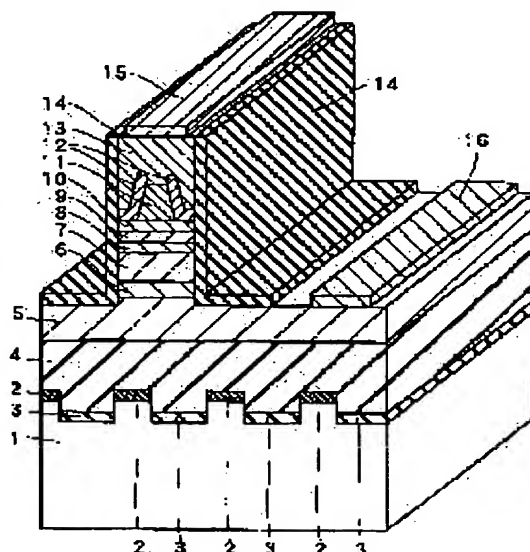
(72)Inventor : HATA MASAYUKI
KUNISATO TATSUYA
HAYASHI NOBUHIKO

(54) NITRIDE-BASE SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FORMING NITRIDE-BASE SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nitride-base semiconductor device that is excellent in mass production and has excellent device characteristics.

SOLUTION: The nitride-base semiconductor device has a sapphire substrate 1 having a surface of bumps and dips, a mask layer 2 formed so as to contact only the tops of bumps of the sapphire substrate 1, an undoped GaN layer 4 formed on the dips of the sapphire substrate 1 and the mask layer 2, and layers 5 to 13 that are formed on the undoped GaN layer 4 and constitute a nitride-base semiconductor device layer having a device region.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-252421

(P2002-252421A)

(43) 公開日 平成14年9月6日(2002.9.6)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

データベース(参考)

H 0 1 S 5/323

H 0 1 S 5/323

5 F 0 4 5

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/205

5 F 0 7 3

審査請求 有 請求項の数11 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2001-51348(P2001-51348)

(71) 出願人 000001889

(22) 出願日 平成13年2月27日(2001.2.27)

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 畑 雅幸

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72) 発明者 國里 竜也

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74) 代理人 100104433

弁理士 宮園 博一

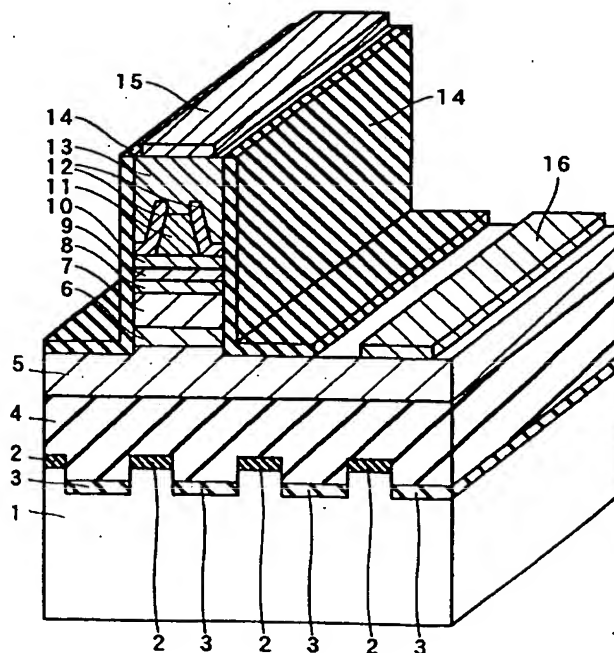
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化物系半導体素子および窒化物系半導体の形成方法

(57) 【要約】

【課題】 量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を提供する。

【解決手段】 凹凸形状の表面を有するサファイア基板1と、サファイア基板1の凹凸形状の凸部上のみに接触するように形成されたマスク層2と、サファイア基板1の凹部上およびマスク層2上に形成されたアンドープGaN層4と、アンドープGaN層4上に形成され、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を構成する各層5～13とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 凹凸形状の表面を有する基板と、
前記基板の凹凸形状の凸部上のみに接触するように形成されたマスク層と、
前記基板の凹部上および前記マスク層上に形成された第1窒化物系半導体層と、
前記第1窒化物系半導体層上に形成され、素子領域を有する窒化物系半導体素子層とを備えた、窒化物系半導体素子。

【請求項2】 前記基板は、サファイア基板、スピネル 10
基板、Si基板、SiC基板、GaN基板、GaAs基板、GaP基板、InP基板および水晶基板からなるグループより選択される1つの基板を含む、請求項1に記載の窒化物系半導体素子。

【請求項3】 前記基板の凹部と前記第1窒化物系半導体層との界面に形成されたバッファ層をさらに備える、請求項1または2に記載の窒化物系半導体素子。

【請求項4】 基板上に形成され、凹凸形状の表面を有する窒化物系半導体からなる下地層と、
前記下地層の凹凸形状の凸部上のみに接触するように形成されたマスク層と、
前記下地層の凹部上および前記マスク層上に形成された第1窒化物系半導体層と、
前記第1窒化物系半導体層上に形成され、素子領域を有する窒化物系半導体素子層とを備えた、窒化物系半導体素子。

【請求項5】 前記基板と前記下地層との間に形成されたバッファ層をさらに備える、請求項4に記載の窒化物系半導体素子。

【請求項6】 前記基板は、サファイア基板、スピネル 30
基板、Si基板、SiC基板、GaAs基板、GaP基板、InP基板および水晶基板からなるグループより選択される1つの基板を含む、請求項4または5に記載の窒化物系半導体素子。

【請求項7】 基板の表面に凹凸形状を形成する工程と、
前記基板の凹凸形状の凸部上のみに接触するように、マスク層を形成する工程と、
前記マスク層をマスクとして、前記基板の凹部上および前記マスク層上に第1窒化物系半導体層を成長させる工程とを備えた、窒化物系半導体の形成方法。

【請求項8】 前記第1窒化物系半導体層を成長させる工程に先立って、前記基板の凹部上にバッファ層を形成する工程をさらに備える、請求項7に記載の窒化物系半導体の形成方法。

【請求項9】 基板上に窒化物系半導体からなる下地層を形成する工程と、
前記下地層の表面に凹凸形状を形成する工程と、
前記下地層の凹凸形状の凸部上のみに接触するように、マスク層を形成する工程と、

前記マスク層をマスクとして、前記下地層の凹部上および前記マスク層上に第1窒化物系半導体層を成長させる工程とを備えた、窒化物系半導体の形成方法。

【請求項10】 前記窒化物系半導体からなる下地層を形成する工程に先だって、前記基板上にバッファ層を形成する工程をさらに備える、請求項9に記載の窒化物系半導体の形成方法。

【請求項11】 前記第1窒化物系半導体層上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を成長させる工程をさらに備える、請求項7～10のいずれか1項に記載の窒化物系半導体の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、窒化物系半導体素子および窒化物系半導体の形成方法に関し、より特定的には、選択横方向成長を用いて形成した窒化物系半導体層を含む窒化物系半導体素子および窒化物系半導体の形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、発光ダイオード素子および半導体レーザ素子などの半導体発光素子やトランジスタなどの電子素子に用いられる半導体素子として、III族窒化物系半導体を利用した窒化物系半導体素子の開発が盛んに行われている。このような窒化物系半導体素子の製造の際には、サファイアなどからなる基板上に、窒化物系半導体層をエピタキシャル成長させている。

【0003】この場合、サファイアなどの基板と窒化物系半導体層とは、格子定数が異なるため、サファイアなどの基板上に成長させた窒化物系半導体層では、基板から上下方向に延びる転位（格子欠陥）が存在している。このような窒化物系半導体層における転位は、半導体素子の素子特性の劣化および信頼性の低下を招く。

【0004】そこで、上記のような窒化物系半導体層における転位を低減する方法として、従来、選択横方向成長が提案されている。この選択横方向成長については、たとえば、International Workshop on Nitride Semiconductors-IWN2000-、Nagoya, Japan, 2000, p. 79などに開示されている。

【0005】図29～図33は、従来の選択横方向成長を用いた窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。次に、図29～図33を参照して、従来の選択横方向成長を用いた窒化物系半導体の形成方法について説明する。

【0006】まず、図29に示すように、サファイアまたはSiCなどからなる基板101上に、下地となるGaN層102を形成する。次に、GaN層102上の所定領域に、マスク層103を形成する。

【0007】次に、マスク層103をマスクとして、マスク層103が形成されていない領域下の部分のGaN

層102をエッチングにより除去するとともに、基板101を基板101の底面に達しない範囲の厚み分だけエッチングする。これにより、図30に示すように、基板101を凹凸形状に形成するとともに、基板101の凸部の上面のほぼ全面に接触するようにパターンニングされたGa_{0.5}N層102を形成する。

【0008】次に、図31に示すように、Ga_{0.5}N層102の露出した側面を種結晶として、アンドープGa_{0.5}N層104の再成長を行う。初期段階では、アンドープGa_{0.5}N層104は、横方向に成長する。図31に示す状態からさらに成長が進むと、図32に示すように、アンドープGa_{0.5}N層104は、上方に成長するとともに、マスク層103上を横方向に成長する。このとき、アンドープGa_{0.5}N層104と、基板101の凹部の底面との間には、空洞部105が形成されている。そして、マスク層103上を横方向成長したアンドープGa_{0.5}N層104が合体して、連続的なアンドープGa_{0.5}N層104が形成される。これにより、図33に示すように、表面が平坦化されたアンドープGa_{0.5}N層104が形成される。

【0009】上記のように、従来の窒化物系半導体の形成方法では、Ga_{0.5}N層102の露出した側面を種結晶として、アンドープGa_{0.5}N層104を選択横方向成長によって形成することにより、Ga_{0.5}N層102の格子欠陥は、アンドープGa_{0.5}N層104の表面付近には伝搬されない。これにより、転位密度の低減されたアンドープGa_{0.5}N層104が得られる。このような転位密度が低減されたアンドープGa_{0.5}N層104上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層（図示せず）を形成すれば、良好な結晶性を有する窒化物系半導体素子を形成することができる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した従来の選択横方向成長を用いる窒化物系半導体の形成方法では、マスク層103が形成されていない領域下の部分のGa_{0.5}N層102を、エッチングにより除去した後、さらに、基板101をエッチングすることにより、基板101に凹凸形状を形成していた。このため、従来では、エッチングされにくい窒化物系半導体層であるGa_{0.5}N層102をその厚み全体にわたってエッチングするとともに、基板101の表面もエッチングする必要があった。それによって、基板101に凹凸形状を形成する際のエッチング時間が長くなるという不都合が生じる。その結果、窒化物系半導体の量産性が低下するという問題点があった。

【0011】また、上記した従来の選択横方向成長を用いる窒化物系半導体の形成方法では、基板101上に、下地となるGa_{0.5}N層102を成長させた後に、Ga_{0.5}N層102を選択横方向成長させることによって、アンドープGa_{0.5}N層104を形成していた。このため、従来では、Ga_{0.5}N層102およびアンドープGa_{0.5}N層104の

2回の結晶成長工程が必要であった。従来では、この点でも、窒化物系半導体の量産性が低下するという問題点があった。

【0012】この発明の1つの目的は、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を提供することである。

【0013】この発明のもう1つの目的は、量産性に優れ、かつ、低転位密度の窒化物系半導体層を得ることが可能な窒化物系半導体の形成方法を提供することである。

【0014】

【課題を解決するための手段】この発明の第1の局面による窒化物系半導体素子は、凹凸形状の表面を有する基板と、基板の凹凸形状の凸部上のみ接触するように形成されたマスク層と、基板の凹部上およびマスク層上に形成された第1窒化物系半導体層と、第1窒化物系半導体層上に形成され、素子領域を有する窒化物系半導体素子層とを備えている。

【0015】この第1の局面による窒化物系半導体素子では、上記のように、凹凸形状の表面を有する基板と、基板の凹凸形状の凸部上のみ接触するように形成されたマスク層とを設けることによって、マスク層をマスクとして、基板の凹部上およびマスク層上に容易に低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。そして、その低転位密度の第1窒化物系半導体層上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を成長させれば、容易に良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を得ることができる。また、基板の表面を凹凸形状に形成することによって、凹凸形状を形成するために基板の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。さらに、この第1の局面では、基板上の1回の成長で第1窒化物系半導体層を形成することができる。その結果、量産性に優れた窒化物系半導体素子を得ることができる。

【0016】上記第1の局面による窒化物系半導体素子において、好ましくは、基板は、サファイア基板、スピネル基板、Si基板、SiC基板、Ga_{0.5}N基板、GaAs基板、GaP基板、InP基板および水晶基板からなるグループより選択される1つの基板を含む。また、上記の場合、基板の凹部と第1窒化物系半導体層との界面に形成されたバッファ層をさらに備えるのが好ましい。このように構成すれば、バッファ層上により低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。

【0017】この発明の第2の局面による窒化物系半導体素子は、基板上に形成され、凹凸形状の表面を有する窒化物系半導体からなる下地層と、下地層の凹凸形状の凸部上のみ接触するように形成されたマスク層と、下地層の凹部上およびマスク層上に形成された第1窒化物系半導体層と、第1窒化物系半導体層上に形成され、素

子領域を有する窒化物系半導体素子層とを備えている。

【0018】この第2の局面による窒化物系半導体素子では、上記のように、凹凸形状の表面を有する下地層と、下地層の凹凸形状の凸部上のみに接触するように形成されたマスク層とを設けることによって、マスク層をマスクとして、下地層の凹部上およびマスク層上に容易に低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。そして、その低転位密度の第1窒化物系半導体層上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を成長させれば、容易に良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を得ることができる。また、窒化物系半導体からなる下地層の表面を凹凸形状に形成することによって、凹凸形状を形成するために窒化物系半導体からなる下地層の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができ、その結果、量産性に優れた窒化物系半導体素子を得ることができる。

【0019】上記第2の局面による窒化物系半導体素子において、好ましくは、基板と下地層との間に形成されたバッファ層をさらに備える。このように構成すれば、バッファ層上に容易に低転位密度の窒化物系半導体からなる下地層を形成することができる。上記の場合、好ましくは、基板は、サファイア基板、スピネル基板、Si基板、SiC基板、GaAs基板、GaP基板、InP基板および水晶基板からなるグループより選択される1つの基板を含む。

【0020】この発明の第3の局面による窒化物系半導体の形成方法は、基板の表面に凹凸形状を形成する工程と、基板の凹凸形状の凸部上のみに接触するように、マスク層を形成する工程と、マスク層をマスクとして、基板の凹部上およびマスク層上に第1窒化物系半導体層を成長させる工程とを備えている。

【0021】この第3の局面による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、基板の表面に凹凸形状を形成するとともに、基板の凹凸形状の凸部上のみに接触するようにマスク層を形成することによって、マスク層をマスクとして、第1窒化物系半導体層を成長させれば、基板の凹部上およびマスク層上に容易に低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。また、基板の表面に凹凸形状を形成することによって、凹凸形状を形成するために基板の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。さらに、この第3の局面では、基板上の1回の成長で第1窒化物系半導体層を形成することができる。その結果、量産性に優れた窒化物系半導体の製造方法を得ることができる。

【0022】上記第3の局面による窒化物系半導体の形成方法において、好ましくは、第1窒化物系半導体層を成長させる工程に先立って、基板の凹部上にバッファ層を形成する工程をさらに備える。このように構成すれ

ば、バッファ層上により低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。

【0023】この発明の第4の局面による窒化物系半導体の形成方法は、基板上に窒化物系半導体からなる下地層を形成する工程と、下地層の表面に凹凸形状を形成する工程と、下地層の凹凸形状の凸部上のみに接触するように、マスク層を形成する工程と、マスク層をマスクとして、下地層の凹部上およびマスク層上に第1窒化物系半導体層を成長させる工程とを備えている。

【0024】この第4の局面による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、基板上の窒化物系半導体からなる下地層の表面に凹凸形状を形成するとともに、下地層の凹凸形状の凸部上のみに接触するようにマスク層を形成することによって、マスク層をマスクとして、第1窒化物系半導体層を成長させれば、下地層の凹部上およびマスク層上に容易に低転位密度の第1窒化物系半導体層を形成することができる。また、窒化物系半導体からなる下地層の表面に凹凸形状を形成することによって、凹凸形状を形成するために下地層の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができ、その結果、量産性に優れた窒化物系半導体の製造方法を提供することができる。

【0025】上記第4の局面による窒化物系半導体の形成方法において、好ましくは、窒化物系半導体からなる下地層を形成する工程に先だって、基板上にバッファ層を形成する工程をさらに備える。このように構成すれば、バッファ層上に容易に低転位密度の窒化物系半導体からなる下地層を形成することができる。

【0026】上記の場合、好ましくは、第1窒化物系半導体層上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を成長させる工程をさらに備える。このように構成すれば、低転位密度の第1窒化物系半導体層上に、素子領域を有する窒化物系半導体素子層を成長させることができるので、容易に良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を形成することができる。

【0027】

【発明の実施形態】以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。

【0028】（第1実施形態）図1～図6は、本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。図1～図6を参照して、第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法について説明する。

【0029】まず、図1に示すように、サファイア（001）面基板1（以下、「サファイア基板1」という）上に、約0.5μmの膜厚を有するストライブ状のSiO₂からなるマスク層2を形成する。マスク層2のストライブパターンは、マスク層2の幅が約5μmで、隣接するマスク層2間の間隔（マスク開口部の幅）が約

2 μm となるように、約 7 μm の周期で形成する。また、ストライプ状のマスク層 2 は、サファイア基板 1 の [1-100] 方向と平行な方向に形成する。なお、サファイア基板 1 が、本発明の「基板」の一例である。

【0030】このマスク層 2 をマスクとして、RIE (Reactive Ion Etching) 法などを用いて、サファイア基板 1 の表面を約 1 μm の厚み分だけエッチングする。これにより、図 2 に示すように、サファイア基板 1 の表面に凹凸形状を形成する。凹凸の形状はエッチング条件により異なり、凹部の上部の幅より凹部の底部の幅の方が広くなることもあれば、狭くなることもある。以下では、サファイア基板 1 のエッチングされた凹部の側面が、サファイア基板 1 の表面に対してほぼ垂直な形状になる場合を示す。また、サファイア基板 1 の凹凸形状は、約 1 μm の高さと同約 2 μm のテラス幅 (サファイア基板 1 の凹部の底面の幅) とを有するとともに、サファイア基板 1 の [1-100] 方向と平行な方向に形成される。

【0031】次に、図 3 に示すように、MOVPE 法 (Metal Organic Vapor Phase Epitaxy: 有機金属気相成長法) などの結晶成長法を用いて、サファイア基板 1 の凹部の底面のほぼ全面と接触するように、約 15 nm の膜厚を有する GaN からなる低温バッファ層 3 を成長させる。この場合、SiO₂ からなるマスク層 2 上には、低温バッファ層 3 は形成されにくい。あるいは、この場合、凹部の底面だけでなく、凹部の側面に低温バッファ層 3 が形成されていてもよい。また、凹部の底部の全面に低温バッファ層 3 が形成されている必要はなく、凹部の底部の一部に低温バッファ層 3 が形成されていてもよい。なお、この低温バッファ層 3 が、本発明の「バッファ層」の一例である。

【0032】次に、GaN からなる低温バッファ層 3 に、アンドープ GaN 層 4 を成長させる。この場合、低温バッファ層 3 およびアンドープ GaN 層 4 の成長は、連続的に行われる。初期段階では、アンドープ GaN 層 4 は、低温バッファ層 3 上に、縦方向 (上方向) に成長する。加えて、凹部の側面に低温バッファ層 3 が形成されている場合には、側面の低温バッファ層 3 から横方向にアンドープ GaN 層 4 が成長する。さらに、アンドープ GaN 層 4 の成長を続けると、図 4 に示すように、側面にファセットを有するアンドープ GaN 層 4 が、凹部の上部に形成される。なお、このアンドープ GaN 層 4 が、本発明の「第 1 窒化物系半導体層」の一例である。

【0033】そして、図 4 に示す状態からさらにアンドープ GaN 層 4 の成長が進むと、アンドープ GaN 層 4 は、図 5 に示すように、マスク層 2 上を横方向に成長する。そして、マスク層 2 上を横方向成長したアンドープ GaN 層 4 が合体して、連続的なアンドープ GaN 層 4 が形成される。これにより、図 6 に示すように、表面が

平坦化された約 5 μm の膜厚を有するアンドープ GaN 層 4 が形成される。

【0034】第 1 実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、サファイア基板 1 の凹部からアンドープ GaN 層 4 を成長させることによって、凹部の側面の低温バッファ層 3 から横方向に成長する際や、マスク層 2 上を横方向に成長する際に、アンドープ GaN 層 4 の転位は、アンドープ GaN 層 4 の (0001) 面内方向に折れ曲がる。これにより、表面付近の転位が低減された低転位のアンドープ GaN 層 4 を形成することができる。

【0035】また、第 1 実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、サファイア基板 1 の表面に凹凸形状を形成することによって、マスク層 2 をマスクとして、サファイア基板 1 の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、図 30 に示した従来の凹凸形状を形成するためのプロセスに比べて、サファイア基板 1 に凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。その結果、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0036】また、第 1 実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、サファイア基板 1 の凹部に形成された GaN からなる低温バッファ層 3 の成長と、アンドープ GaN 層 4 の選択成長とは、連続的に行われる。これにより、1 回の成長工程で、低転位のアンドープ GaN 層 4 を形成することができる。この点でも、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0037】また、第 1 実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、サファイア基板 1 上に設けた低温バッファ層 3 上に、アンドープ GaN 層 4 を成長させることによって、サファイア基板 1 上に直接アンドープ GaN 層 4 を成長させる場合に比べて、より低転位のアンドープ GaN 層 4 を成長させることができる。

【0038】図 7 は、上記した第 1 実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。次に、図 7 を参照して、第 1 実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子の構造について説明する。

【0039】第 1 実施形態の半導体レーザ素子の構造としては、図 6 に示した第 1 実施形態のアンドープ GaN 層 4 上に、図 7 に示すように、約 4 μm の膜厚を有する n 型 GaN からなる n 型コンタクト層 5 が形成されている。n 型コンタクト層 5 上には、約 0.1 μm の膜厚を有する n 型 AlGaInN からなるクラック防止層 6、約 0.45 μm の膜厚を有する n 型 AlGaInN からなる n 型第 2 クラッド層 7、約 50 nm (約 0.05 μm) の膜厚を有する n 型 GaN からなる n 型第 1 クラッド層 8、および、GaInN からなる多重量子井戸 (MQW) 発光層 9 が順次形成されている。この MQW 発光層

9は、約4nmの厚みを有する5つのアンドープGa_{0.4}N障壁層と、約4nmの厚みを有する4つの圧縮歪みのアンドープGa_{0.6}In_{0.4}N井戸層とが交互に積層された構造を有する。

【0040】MQW発光層9上には、約40nm（約0.04μm）の膜厚を有するp型Ga_{0.4}Nからなるp型第1クラッド層10が形成されている。p型第1クラッド層10上には、約0.45μmの高さを有するメサ形状（台形状）のp型AlGa_{0.4}Nからなるp型第2クラッド層11が形成されている。また、p型第1クラッド層10上の、p型第2クラッド層11が形成されている領域以外の領域と、メサ形状のp型第2クラッド層11の側面とを覆うとともに、p型第2クラッド層11の上面を露出させるように、約0.2μmの膜厚を有するn型Ga_{0.4}Nからなる電流阻止層12が形成されている。電流阻止層12上には、露出されたp型第2クラッド層11の上面と接触するように、約3μm〜約5μmの膜厚を有するp型Ga_{0.4}Nからなるp型コンタクト層13が形成されている。

【0041】また、p型コンタクト層13からn型コンタクト層5までの一部領域が除去されている。そのn型コンタクト層5の露出した表面の一部と、クラック防止層6、n型第2クラッド層7、n型第1クラッド層8、MQW発光層9、p型第1クラッド層10、電流阻止層12およびp型コンタクト層13の露出した側面とを覆うように、SiO₂またはSi₃N₄などの絶縁膜からなる保護膜14が形成されている。

【0042】また、p型コンタクト層13の上面上には、p型電極15が形成されるとともに、一部領域が除去されて露出されたn型コンタクト層5の表面には、n型電極16が形成されている。

【0043】なお、n型コンタクト層5、クラック防止層6、n型第2クラッド層7、n型第1クラッド層8、MQW発光層9、p型第1クラッド層10、p型第2クラッド層11、電流阻止層12およびp型コンタクト層13は、本発明の「素子領域を有する窒化物系半導体素子層」の一例である。

【0044】第1実施形態の半導体レーザ素子では、上記のように、図1〜図6に示した第1実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて形成された、量産性に優れ、かつ、低転位のアンドープGa_{0.4}N層4を下地として、その上に各層5〜13を形成することによって、各層5〜13において良好な結晶性を実現することができる。その結果、第1実施形態では、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する半導体レーザ素子を得ることができる。

【0045】（第2実施形態）図8〜図13は、本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。この第2実施形態では、第1実施形態の絶縁性のサファイア基板1の代わりに、導電

性を有するn型のSi（111）面基板21（以下、「Si基板21」という）を用いている。図8〜図13を参照して、第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法について説明する。

【0046】まず、この第2実施形態では、図8に示すように、n型のSi基板21上に、約0.5μmの膜厚を有するストライプ状のSiO₂からなるマスク層22を形成する。マスク層22のストライプパターンは、マスク層22の幅が約5μmで、隣接するマスク層22間の間隔（マスク開口部の幅）が約2μmとなるように、約7μmの周期で形成する。また、ストライプ状のマスク層22は、Si基板21の[1-10]方向と平行な方向に形成する。なお、Si基板21が、本発明の「基板」の一例である。

【0047】このマスク層22をマスクとして、ウェットエッチング法などを用いて、Si基板21の表面を約1μmの厚み分だけエッチングする。これにより、図9に示すように、Si基板21の表面に凹凸形状を形成する。凹凸の形状はエッチング条件により異なり、凹部の上部の幅より凹部の底部の幅の方が広がることもあれば、狭くなることもある。以下では、Si基板21のエッチングにより形成された凸部がメサ形状（台形状）になる場合を示す。また、Si基板21の凹凸形状は、約1μmの高さを有するとともに、Si基板21の[1-10]方向と平行な方向に形成される。

【0048】次に、図10に示すように、MOVPE法などの結晶成長法を用いて、Si基板21の凹部の底面のほぼ全面と接触するように、約15nmの膜厚を有するSiドープAlGa_{0.4}Nからなるバッファ層23を成長させる。この場合、SiO₂からなるマスク層22上には、バッファ層23は形成されにくい。あるいは、この場合、凹部の底面だけでなく、凹部の側面にバッファ層23が形成されていてもよい。また、凹部の底部の全面にバッファ層23が形成されている必要はなく、凹部の底部の一部にバッファ層23が形成されていてもよい。

【0049】次に、SiドープAlGa_{0.4}Nからなるバッファ層23に、SiドープGa_{0.4}N層24を成長させる。この場合、バッファ層23およびSiドープGa_{0.4}N層24の成長は、連続的に行われる。初期段階では、SiドープGa_{0.4}N層24は、バッファ層23上を縦方向（上方向）に成長する。加えて、凹部の側面にバッファ層23が形成されている場合には、側面のバッファ層23から横方向にSiドープGa_{0.4}N層24が成長する。さらに、SiドープGa_{0.4}N層24の成長を続けると、図11に示すように、側面にファセットを有するSiドープGa_{0.4}N層24が、凹部の上部に形成される。なお、このSiドープGa_{0.4}N層24が、本発明の「第1窒化物系半導体層」の一例である。

【0050】そして、図11に示す状態からさらにSiドープGa_{0.4}N層24の成長が進むと、SiドープGa_{0.4}N

層24は、図12に示すように、マスク層22上を横方向に成長する。そして、マスク層22上を横方向成長したSiドープGaN層24が合体して、連続的なSiドープGaN層24が形成される。これにより、図13に示すように、表面が平坦化された約5 μ mの膜厚を有するSiドープGaN層24が形成される。

【0051】第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、Si基板21の凹部からSiドープGaN層24を成長させることによって、凹部の側面のバッファ層23から横方向に成長する際や、マスク層22上を横方向に成長する際に、SiドープGaN層24の転位は、SiドープGaN層24の(0001)面内方向に折れ曲がる。これにより、表面付近の転位が低減された低転位のSiドープGaN層24を形成することができる。

【0052】また、第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、第1実施形態と同様、Si基板21の表面に凹凸形状を形成することによって、マスク層22をマスクとして、Si基板21の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、図30に示した従来の凹凸形状を形成するためのプロセスに比べて、Si基板21に凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。その結果、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0053】また、第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、第1実施形態と同様、Si基板21に形成されたSiドープAlGaNからなるバッファ層23の成長と、SiドープGaN層24の選択成長とは、連続的に行われる。これにより、1回の成長工程で、低転位のSiドープGaN層24を形成することができる。この点でも、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0054】また、第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、Si基板21上に設けたバッファ層23上に、SiドープGaN層24を成長させることによって、Si基板21上に直接SiドープGaN層24を成長させる場合に比べて、より低転位のSiドープGaN層24を成長させることができる。

【0055】図14は、上記した第2実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。次に、図14を参照して、第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子の構造について説明する。

【0056】第2実施形態の半導体レーザ素子の構造としては、図13に示した第2実施形態のSiドープGaN層24上に、図14に示すように、約0.1 μ mの膜厚を有するn型AlGaInNからなるクラック防止層25、約0.45 μ mの膜厚を有するn型AlGaNからなるn型第2クラッド層26、約50nm(約0.05) μ mの膜厚を有するn型GaNからなるn型第1ク

ラッド層27、および、GaInNからなる多重量子井戸(MQW)発光層28が順次形成されている。このMQW発光層28は、約4nmの厚みを有する5つのアンドープGaN障壁層と、約4nmの厚みを有する4つの圧縮歪みのアンドープGaInN井戸層とが交互に積層された構造を有する。

【0057】MQW発光層28上には、約40nm(約0.04 μ m)の膜厚を有するp型GaNからなるp型第1クラッド層29が形成されている。p型第1クラッド層29上には、約0.45 μ mの高さを有するメサ形状(台形状)のp型AlGaNからなるp型第2クラッド層30が形成されている。また、p型第1クラッド層29上の、p型第2クラッド層30が形成されている領域以外の領域と、メサ形状のp型第2クラッド層30の側面とを覆うとともに、p型第2クラッド層30の上面を露出させるように、約0.2 μ mの膜厚を有するn型GaNからなる電流阻止層31が形成されている。電流阻止層31上には、露出されたp型第2クラッド層30の上面と接触するように、約3 μ m~約5 μ mの膜厚を有するp型GaNからなるp型コンタクト層32が形成されている。

【0058】また、p型第2クラッド層30のメサ形状を反映したp型コンタクト層32の凸部上には、p型電極33が形成されている。また、この第2実施形態では、第1実施形態のサファイア基板1と異なり、Si基板21が導電性を有するので、Si基板21の裏面に、n型電極34が形成されている。

【0059】なお、クラック防止層25、n型第2クラッド層26、n型第1クラッド層27、MQW発光層28、p型第1クラッド層29、p型第2クラッド層30、電流阻止層31およびp型コンタクト層32は、本発明の「素子領域を有する窒化物系半導体素子層」の一例である。

【0060】第2実施形態の半導体レーザ素子では、上記のように、図8~図13に示した第2実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて形成された、量産性に優れ、かつ、低転位のSiドープGaN層24を下地として、その上に各層25~32を形成することによって、各層25~32において良好な結晶性を実現することができる。その結果、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する半導体レーザ素子を得ることができる。

【0061】たとえば、上記第1および第2実施形態では、基板として、サファイア基板1およびSi基板21を用いたが、本発明はこれに限らず、スピネル基板、SiC基板、GaAs基板、GaP基板、InP基板または水晶基板を用いてもよい。

【0062】加えて、上記第1および第2実施形態では、基板として、GaN基板を用いてもよい。この場合、必ずしも低温バッファ層3を形成する必要はなく、あるいはバッファ層23を形成する必要はない。

【0063】(第3実施形態)図15～図20は、本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。この第3実施形態では、サファイア(0001)面基板41(以下、「サファイア基板41」という)上に形成した凹凸形状を有する下地層43を用いて選択横方向成長を行う例を示している。以下、図15～図20を参照して、第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法について詳細に説明する。

【0064】まず、この第3実施形態では、図15に示すように、MOVPE法などの結晶成長法を用いて、サ 10
ファイア基板41上に、約15nmの膜厚を有するAlGa_{0.3}Nからなる低温バッファ層42、および、約2μmの膜厚を有するアンドープGa_{0.3}Nからなる下地層43を形成する。なお、サファイア基板41が、本発明の「基板」の一例である。また、この低温バッファ層42が、本発明の「バッファ層」の一例である。

【0065】下地層43上には、約0.5μmの膜厚を有するストライプ状のSiO₂からなるマスク層44を形成する。マスク層44のストライプパターンは、マ 20
スク層44の幅が約5μmで、隣接するマスク層44間の間隔(マスク開口部の幅)が約1μmとなるように、約6μmの周期で形成する。また、ストライプ状のマスク層44は、Ga_{0.3}Nからなる下地層43の[11-20]方向と平行な方向に形成する。

【0066】このマスク層44をマスクとして、RIE法などを用いて、下地層43の表面を約1μmの厚み分だけエッチングする。これにより、図16に示すよう 30
に、下地層43の表面に凹凸形状を形成する。凹凸の形状はエッチング条件により異なり、凹部の上部の幅より凹部の底部の幅の方が広くなることもあれば、狭くなることもある。以下では、下地層43のエッチングにより形成された凸部がメサ形状(台形状)になる場合を示す。また、下地層43の凹凸形状は、約1μmの高さを有するとともに、アンドープGa_{0.3}Nからなる下地層43の[11-20]方向と平行な方向に形成される。

【0067】次に、図17に示すように、アンドープGa_{0.3}Nからなる下地層43の露出された凹部の底面および側面を種結晶として、アンドープGa_{0.3}N層45を再成長させる。初期段階では、アンドープGa_{0.3}N層45は、図 40
17および図18に示すように、下地層43の凹部の底面から縦方向(上方向)に成長するとともに、下地層43の側面から横方向にも成長する。なお、このアンドープGa_{0.3}N層45が、本発明の「第1窒化物系半導体層」の一例である。

【0068】そして、図18に示す状態からさらにアンドープGa_{0.3}N層45の成長が進むと、アンドープGa_{0.3}N層45は、図19に示すように、マスク層44上を横方向に成長する。そして、マスク層44上を横方向成長したアンドープGa_{0.3}N層45が合体して、連続的なアンド 50
ープGa_{0.3}N層45が形成される。これにより、図20に

示すように、表面が平坦化された約5μmの膜厚を有するアンドープGa_{0.3}N層45が形成される。

【0069】第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、アンドープGa_{0.3}Nからなる下地層43の凹部の底面および側面を種結晶として、アンドープGa_{0.3}N層45を成長させることによって、側面の 1
下地層43から横方向に成長する際や、マスク層44上を横方向に成長する際に、アンドープGa_{0.3}N層45の転位は、アンドープGa_{0.3}N層45の(0001)面内方向に折れ曲がる。これにより、表面付近の転位が低減された低転位のアンドープGa_{0.3}N層45を形成することができる。

【0070】また、第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、下地層43の表面に凹凸形状を形成することによって、下地層43の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、図30に示した従来の凹凸形状を形成するためのプロセスに比べて、下地層43に凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。その結果、第1および第2実施形態と同様、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0071】また、第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、サファイア基板41上に、低温バッファ層42を形成した後、アンドープGa_{0.3}Nからなる下地層43を成長させるので、容易の低転位の下地層43を形成することができる。

【0072】図21は、上記した第3実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。次に、図21を参照して、第3 30
実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子の構造について説明する。

【0073】第3実施形態の半導体レーザ素子の構造としては、図20に示したアンドープGa_{0.3}N層45上に、第1実施形態と同様、n型コンタクト層5、クラック防止層6、n型第2クラッド層7、n型第1クラッド層8、MQW発光層9、p型第1クラッド層10、p型第2クラッド層11、電流阻止層12、p型コンタクト層13および保護膜14が形成されている。なお、各層5～13および保護膜14の組成および膜厚は、第1実施形態と同様である。

【0074】また、p型コンタクト層13の上面上には、p型電極15が形成されるとともに、一部領域が除去されて露出されたn型コンタクト層5の表面には、n型電極16が形成されている。

【0075】第3実施形態の半導体レーザ素子では、上記のように、図15～図20に示した第3実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて形成された量産性に優れ、かつ、低転位のアンドープGa_{0.3}N層45を下地として、その上に各層5～13を形成することによって、各層5～13において良好な結晶性を実現することができ 50

る。その結果、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する半導体レーザ素子を得ることができる。

【0076】(第4実施形態)図22～図27は、本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。この第4実施形態では、第3実施形態の絶縁性のサファイア基板41の代わりに、導電性を有するn型のSiC(0001)面基板51

(以下、「SiC基板51」という)を用いている。図22～図27を参照して、第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法について説明する。

【0077】まず、この第4実施形態では、図22に示すように、MOVPE法などの結晶成長法を用いて、n型のSiC基板51上に、約15nmの膜厚を有するSiドープAlGaInからなるバッファ層52、および、約2μmの膜厚を有するSiドープGaNからなる下地層53を形成する。なお、SiC基板51が、本発明の「基板」の一例である。

【0078】下地層53上には、約0.5μmの膜厚を有するストライプ状のSiO₂からなるマスク層54を形成する。マスク層54のストライプパターンは、マスク層54の幅が約5μmで、隣接するマスク層54間の間隔(マスク開口部の幅)が約1μmとなるように、約6μmの周期で形成する。また、ストライプ状のマスク層54は、SiドープGaNからなる下地層53の[11-20]方向と平行な方向に形成する。

【0079】このマスク層54をマスクとして、RIE法などを用いて、下地層53の表面を約1μmの厚み分だけエッチングする。これにより、図23に示すように、下地層53の表面に凹凸形状を形成する。凹凸の形状はエッチング条件により異なり、凹部の上部の幅より凹部の底部の幅の方が広がることもあれば、狭くなることもある。以下では、下地層53のエッチング条件により形成された凸部がメサ形状(台形状)になる場合を示す。また、下地層53の凹凸形状は、約1μmの高さを有するとともに、SiドープGaNからなる下地層53の[11-20]方向と平行な方向に形成される。

【0080】次に、図24に示すように、SiドープGaNからなる下地層53の露出された凹部の底面および側面を種結晶として、SiドープGaN層55を再成長させる。初期段階では、SiドープGaN層55は、図24および図25に示すように、下地層53の凹部の底面から縦方向(上方向)に成長するとともに、下地層53の側面からも横方向に成長する。なお、このSiドープGaN層55が、本発明の「第1窒化物系半導体層」の一例である。

【0081】そして、図25に示す状態からさらにSiドープGaN層55の成長が進むと、SiドープGaN層55は、図26に示すように、マスク層54上を横方向に成長する。そして、マスク層54上を横方向成長したSiドープGaN層55が合体して、連続的なSiド

ープGaN層55が形成される。これにより、図27に示すように、表面が平坦化された約5μmの膜厚を有するSiドープGaN層55が形成される。

【0082】第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、SiドープGaNからなる下地層53の凹部の底面および側面を種結晶として、SiドープGaN層55を成長させることによって、側面の下地層53から横方向に成長する際や、マスク層54上を横方向に成長する際に、SiドープGaN層55の転位は、SiドープGaN層55の(0001)面内方向に折れ曲がる。これにより、表面付近の転位が低減された低転位のSiドープGaN層55を形成することができる。

【0083】また、第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、上記のように、下地層53の表面に凹凸形状を形成することによって、下地層53の表面のみをエッチングするだけでよい。これにより、図30に示した従来の凹凸形状を形成するためのプロセスに比べて、下地層53に凹凸形状を形成するためのエッチング時間を減少させることができる。その結果、第1～第3実施形態と同様、量産性に優れた窒化物系半導体の形成方法を得ることができる。

【0084】また、第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法では、SiC基板51上に、バッファ層52を形成した後、SiドープGaNからなる下地層53を成長させるので、容易の低転位の下地層53を形成することができる。

【0085】図28は、上記した第4実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。次に、図28を参照して、第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子の構造について説明する。

【0086】第4実施形態の半導体レーザ素子の構造としては、図27に示したSiドープGaN層55上に、第2実施形態と同様、クラック防止層25、n型第2クラッド層26、n型第1クラッド層27、MQW発光層28、p型第1クラッド層29、p型第2クラッド層30、電流阻止層31およびp型コンタクト層32が形成されている。なお、各層25～32の組成および膜厚は、第2実施形態と同様である。

【0087】また、p型第2クラッド層30のメサ形状を反映したp型コンタクト層32の凸部上には、p型電極33が形成されている。また、SiC基板51が導電性を有するので、SiC基板51の裏面に、n型電極34が形成されている。

【0088】第4実施形態の半導体レーザ素子では、上記のように、図22～図27に示した第4実施形態の窒化物系半導体の形成方法を用いて形成された、量産性に優れ、かつ、低転位のSiドープGaN層55を下地として、その上に各層25～32を形成することによ

10

20

30

40

50

て、各層 25～32 において良好な結晶性を実現することができる。その結果、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を得ることができる。

【0089】たとえば、上記第3および第4実施形態では、基板として、サファイア基板 41 および SiC 基板 51 を用いたが、本発明はこれに限らず、スピネル基板、Ga₂N₃基板、GaAs 基板、GaP 基板、InP 基板および水晶基板などを用いてもよい。

【0090】なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。

【0091】また、上記第1～第4実施形態では、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 に、エッチングにより凹凸形状を形成する際に、凹部の高さを約 1 μm に形成したが、本発明はこれに限らず、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 の底面に達しない範囲で、凹部の高さを数 nm～数 μm の範囲で形成するのが好ましい。

【0092】また、上記第1～第4実施形態では、ストライプ状のマスク層を、サファイア基板 1 の [1-100] 方向、Si 基板 21 の [1-10] 方向、または、下地層 43 および 53 の GaN の [11-20] 方向に平行に形成したが、本発明はこれに限らず、上記した方向と異なる方向にストライプ状のマスク層を形成してもよい。たとえば、第3および第4実施形態のマスク層 44 および 54 を、下地層 43 および 53 の GaN の [1-100] 方向に平行に形成してもよい。

【0093】また、上記第1～第4実施形態では、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 の表面の凹凸形状を、サファイア基板 1 の [1-100] 方向、Si 基板 21 の [1-10] 方向、または、下地層 43 および 53 の GaN の [11-20] 方向に平行に形成したが、本発明はこれに限らず、上記した方向と異なる方向に凹凸形状を形成してもよい。たとえば、第3および第4実施形態の下地層 43 および 53 の凹凸形状を、下地層 43 および 53 の GaN の [1-100] 方向に平行に形成してもよい。

【0094】また、上記第1～第4実施形態では、マスク層およびマスク層の開口部を、ストライプ状に形成したが、本発明はこれに限らず、マスク層を、円形、六角形または三角形などの形状で形成してもよく、また、マスク層の開口部を、円形、六角形または三角形などの形状で形成してもよい。マスク層およびマスク層の開口部を、六角形または三角形に形成する場合、六角形または三角形の各辺の方向は、どの結晶方位と一致するように形成してもよい。

【0095】また、上記第1～第4実施形態では、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 の表面の凹部および凸部をストライプ状に形成したが、本発明はこれに限らず、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 の表面の凹部の形状を、円形、六角形または三角形などの形状で形成してもよく、また、凸部の形状を、円形、六角形または三角形などの形状で形成してもよい。凹部または凸部の形状を、六角形または三角形に形成する場合、六角形または三角形の各辺の方向は、どの結晶方位と一致するように形成してもよい。

【0096】また、上記第1～第4実施形態では、窒化物系半導体を用いて半導体レーザ素子を作製したが、本発明はこれに限らず、発光ダイオード素子またはトランジスタなどの窒化物系半導体を用いる他の素子にも適用可能である。

【0097】また、上記第1～第4実施形態において、窒化物系半導体の結晶構造は、ウルツ鉱型構造であってもよいし、閃亜鉛鉱型構造であってもよい。

【0098】また、上記第1～第4実施形態では、窒化物系半導体各層の結晶成長を、MOVPE法を用いて行ったが、本発明はこれに限らず、HVPE法、または、TMAI、TMGa、TMIn、NH₃、SiH₄ および Cp₂Mg などを原料ガスとして用いるガスソースMBE法などを用いて結晶成長を行ってもよい。

【0099】また、第1～第4実施形態において、サファイア基板 1、Si 基板 21、下地層 43 および 53 に形成された凹凸形状の凹部の底面の幅を、数百 nm～数十 μm の範囲で形成するのが好ましい。

【0100】

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、量産性に優れ、かつ、良好な素子特性を有する窒化物系半導体素子を提供することができる。また、量産性に優れ、かつ、低転位密度の窒化物系半導体層を得ることが可能な窒化物系半導体の形成方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図2】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図3】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図4】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図5】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図6】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図7】本発明の第1実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜

視図である。

【図8】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図9】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図10】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図11】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図12】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。 10

【図13】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図14】本発明の第2実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。

【図15】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図16】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。 20

【図17】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図18】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図19】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図20】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図21】本発明の第3実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した 30 斜視図である。

【図22】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図23】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図24】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図25】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図26】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。 40

* 【図27】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図28】本発明の第4実施形態による窒化物系半導体の形成方法を用いて製造した半導体レーザ素子を示した斜視図である。

【図29】従来の窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図30】従来の窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図31】従来の窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図32】従来の窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【図33】従来の窒化物系半導体の形成方法を説明するための断面図である。

【符号の説明】

1、41 サファイア基板（基板）

3、42 低温バッファ層（バッファ層）

2、22、44、54 マスク層

4、45 アンドープGaN層（第1窒化物系半導体層）

5 n型コンタクト層（窒化物系半導体素子層）

6、25 クラック防止層（窒化物系半導体素子層）

7、26 n型第2クラッド層（窒化物系半導体素子層）

8、27 n型第1クラッド層（窒化物系半導体素子層）

9、28 MQW発光層（窒化物系半導体素子層）

10、29 p型第1クラッド層（窒化物系半導体素子層）

11、30 p型第2クラッド層（窒化物系半導体素子層）

12、31 電流阻止層（窒化物系半導体素子層）

13、32 p型コンタクト層（窒化物系半導体素子層）

21 Si基板（基板）

23、52 バッファ層

24、55 SiドープGaN層（第1窒化物系半導体層）

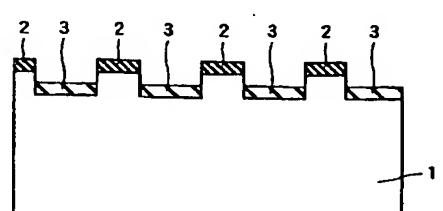
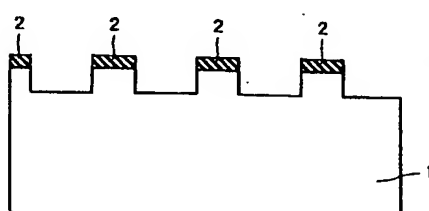
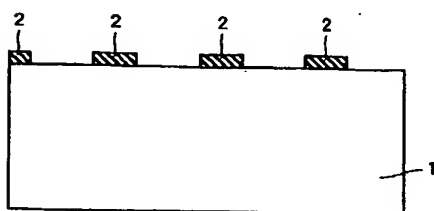
43、53 下地層

* 51 SiC基板（基板）

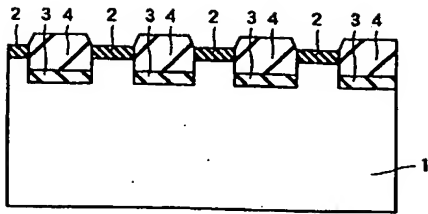
【図1】

【図2】

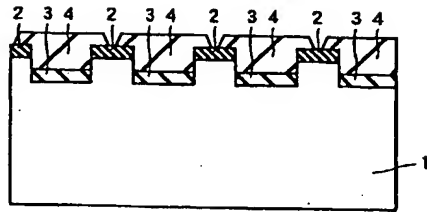
【図3】



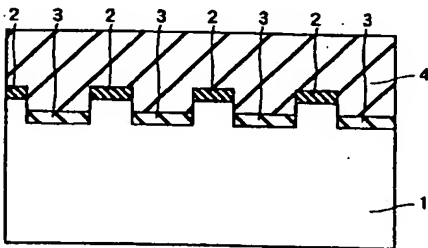
【図4】



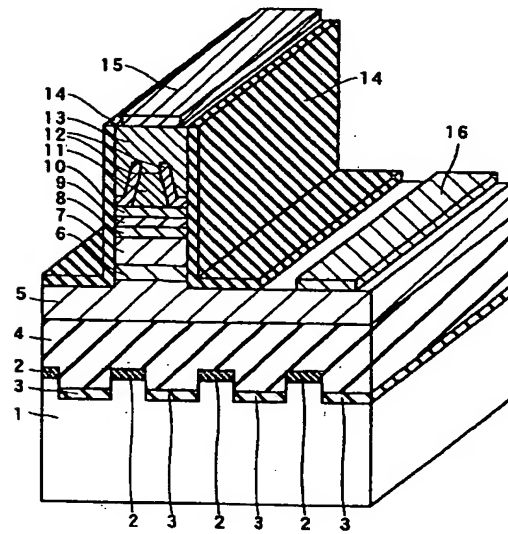
【図5】



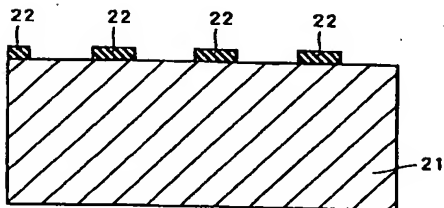
【図6】



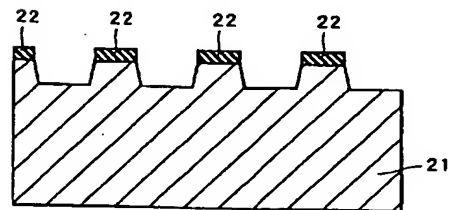
【図7】



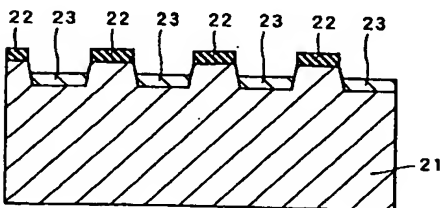
【図8】



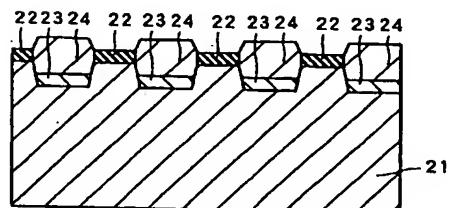
【図9】



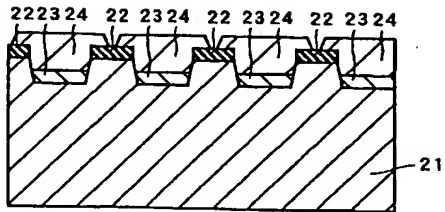
【図10】



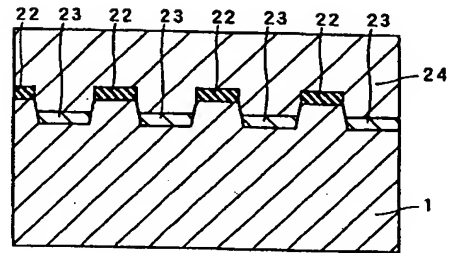
【図11】



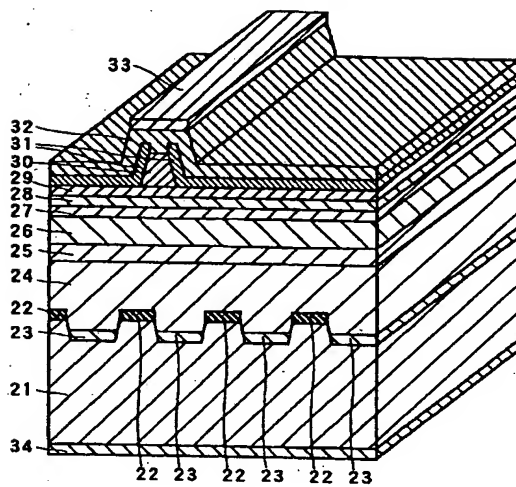
【図 12】



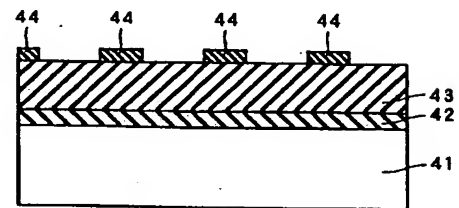
【図 13】



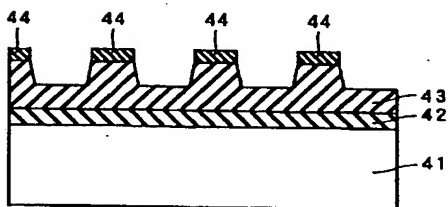
【図 14】



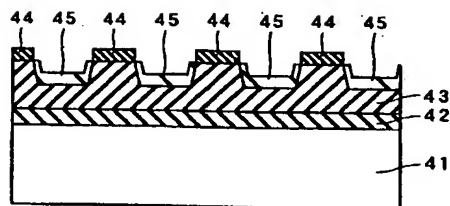
【図 15】



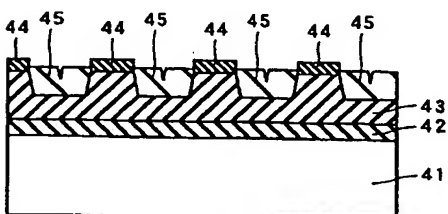
【図 16】



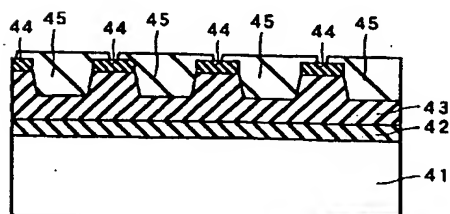
【図 17】



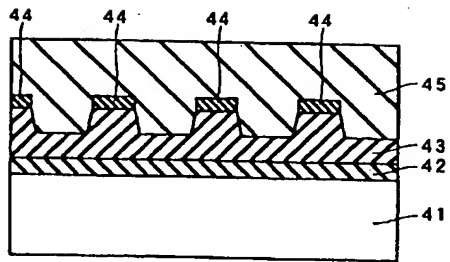
【図 18】



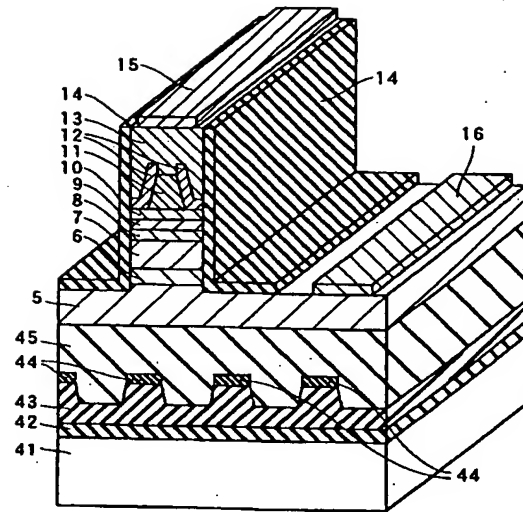
【図 19】



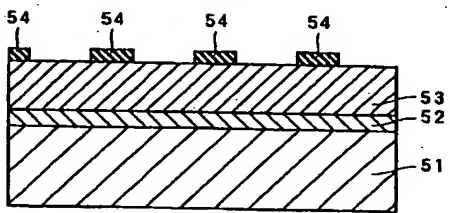
【図20】



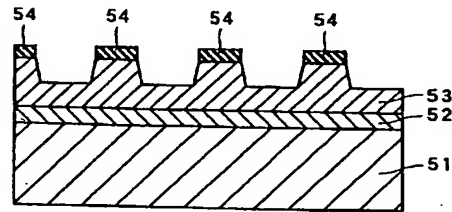
【図21】



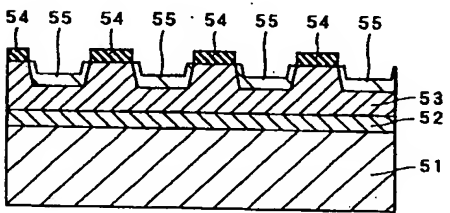
【図22】



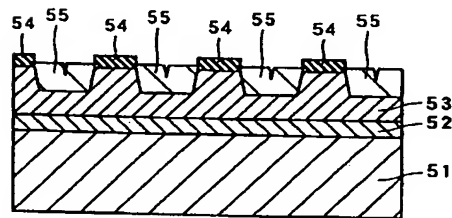
【図23】



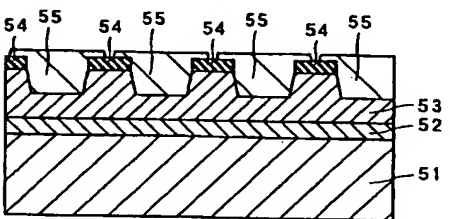
【図24】



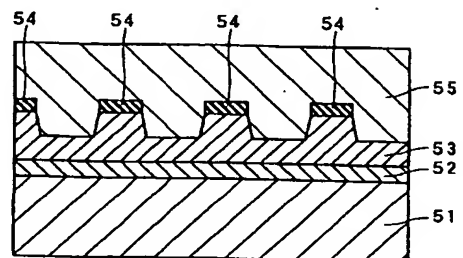
【図25】



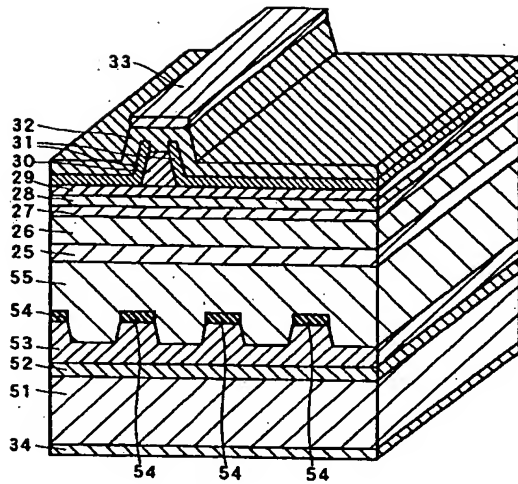
【図26】



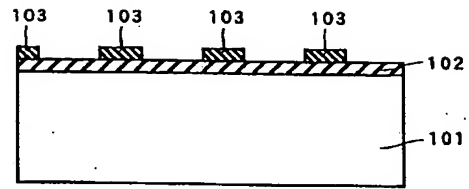
【図27】



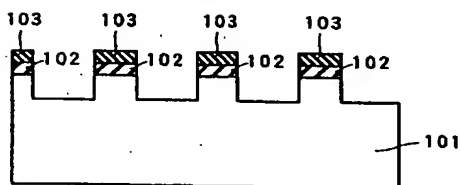
【図28】



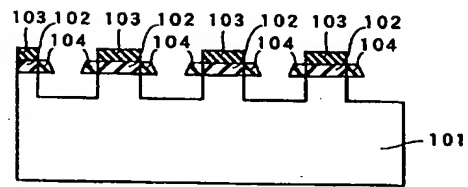
【図29】



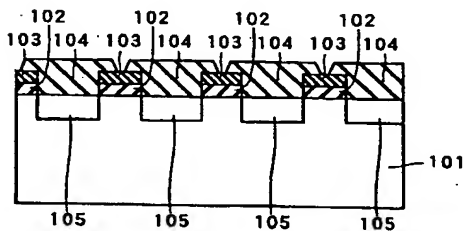
【図30】



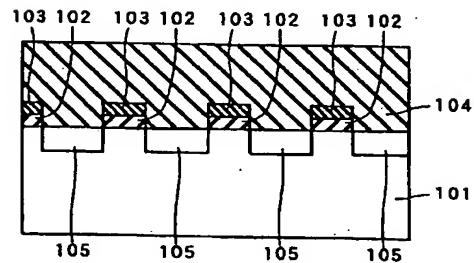
【図31】



【図32】



【図33】



フロントページの続き

(72)発明者 林 伸彦
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

Fターム(参考) 5F045 AA04 AB09 AB14 AB17 AF02
AF03 AF04 AF09 AF12 AF20
CA10 CA12 DA53 DA55 DB02
5F073 AA74 CA07 CB05 CB07 DA05
DA25 EA29